POWERED BY Dialog

NEW CATALYST FOR PHOTOREACTION AND PHOTOCATALYTIC REACTION USING THAT

Publication Number: 2000-051709 (JP 2000051709 A), February 22, 2000

Inventors:

- SAYAMA KAZUHIRO
- KUSAMA HITOSHI
- OKABE KIYOMI
- ARAKAWA HIRONORI

Applicants

• AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

Application Number: 11-219869 (JP 99219869)

Application Number: 07-237424

Application Number: JP 95237424, September 14, 1995

International Class:

- B01J-035/02
- B01J-023/42
- B01J-023/58
- B01J-023/648
- C01B-003/04
- C01B-003/22

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the efficiency of a treatment such as water decomposition or oxidation decomposition of environmental pollutants using a semiconductor photocatalyst by mixing different two or more kinds of semiconductor photocatalysts, and depositing metals selected from among platinum, rhodium, nickel and copper or ruthenium oxide on the semiconductor catalyst. SOLUTION: A semiconductor photocatalyst having different two or more kinds of semiconductor compsns. is used as a photoreaction catalyst which is suitable to carry out the reaction to decompose harmful substances into harmless substances. As for the semiconductor photocatalyst, an oxide semiconductor such as strontium titanate, a sulfide semiconductor such as cadmium sulfide and a carbide such as silicon carbide can be used, and an oxide semiconductor having high activity is preferably used. Then metals or metal oxides are deposited on the semiconductor, and the metals are platinum, rhodium, nickel, copper or the like, and metal oxides are ruthenium oxide or the like. The metals and metal oxides are deposited for example, by first depositing water-soluble metal salts by impregnation and then reducing the salts with hydrogen. COPYRIGHT: (C)2000,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-51709 (P2000-51709A)

(43)公開日 平成12年2月22日(2000.2.22)

(51) Int.Cl.7	識別記号		FΙ				テーマコード(参考)
B 0 1 J 35/02	ZAB		B 0 1	J 35/02		ZABJ	
23/42				23/42		M	
23/58				23/58		M	
23/648			C 0 1	B 3/04		Α	
C 0 1 B 3/04				3/22		A	
		審查請求	有	請求項の数:	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21) 山麻桑县	特願平11-219869		(71) W	題人 00000	11144		
(21)出願番号 (62)分割の表示			(71)出				
	特願平7-237424の分割				支術院長		D 0 402 7 12
(22)出顯日	平成7年9月14日(1995.9.14)		(ma) ma			区段が関1丁	日3番1号
			(72)発	明者 佐山			
				茨城	具つくば	市東1丁目14	番 工業技術院
				物質	工学工業	技術研究所内	
			(72)発	明者 草間	仁		
				茨城!	見つくば	市東1丁目1	番 工業技術院
						技術研究所内	
			(7/1) 均	定代理人			
			(14718			v 質工学工業技術	aconstate et
•				上来:	XVN DG-DJ	貝工于工来仅1	例如为动汉
	_						
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規な光反応用触媒及びそれを使用する光触媒反応方法

(57)【要約】

【課題】従来の半導体光触媒より大幅に高性能な光反応 用触媒及び該触媒を使用する光触媒反応方法を提供する こと

【解決手段】異なる2種類以上の半導体光触媒を混合することからなり、これらの半導体触媒に、白金、ロジウム、ニッケル、銅から選ばれる金属又は酸化ルテニウムを担持させるることを特徴とする光反応用触媒。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 異なる2種類以上の半導体光触媒を混合することからなり、これらの半導体触媒に、白金、ロジウム、ニッケル、銅から選ばれる金属又は酸化ルテニウムを担持させるることを特徴とする光反応用触媒。

1

【請求項2】 光触媒反応において請求項1に記載した 光反応用触媒を使用することを特徴とする光触媒反応方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光反応用触媒及び それを使用する光触媒反応方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体光触媒は、二酸化チタンや酸化亜鉛等の半導体又は該半導体に白金、ロジウム、ニッケル、銅等の金属や酸化ルテニウム等の金属酸化物を担持した触媒である。この触媒に、触媒を構成する半導体のバンドギャップより大きいエネルギーレベルの光を照射すると、伝導帯には電子が価電子帯には正孔が形成され、これらが触媒表面の吸着種に作用して反応が起る。例えば、水を分解して水素と酸素を発生させたり有害物を分解して無害化する反応等である。半導体光触媒は、太陽光を利用する水分解法水素の製造用触媒や有害物分解無害化用触媒として注目されており、今後の発展が期待されている。しかし、現在のところ触媒性能が低いために実用化が進んでおらず、そのため半導体光触媒の性能向上が強く望まれている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の半導体光触媒より大幅に高性能な光反応用触媒及び該触媒を使用する光触媒反応方法を提供することをその課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明によれば、異なる2種類以上の半導体光触媒を混合することからなり、これらの半導体触媒に、白金、ロジウム、ニッケル、銅から選ばれる金属又は酸化ルテニウムを担持させるることを特徴とする光反応用触媒、及びこの触媒を使用することを特徴とする光触媒反応方法が提供される。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明第一の触媒(以下、この触媒を触媒Aとも云う)は、半導体組成が異なる2種類以上の半導体光触媒から成る触媒であり、半導体光触媒としては公知品が使われる。具体的には、二酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化亜鉛、酸化ニオブ等の酸化物半導体;硫化カドミウム等の硫化物半導体;炭化珪素等の炭化物等が使われるが、活性の高い酸化物半導体の使用が好ましい。

また、通常は前記半導体に反応系で安定な金属や金属酸化物等を担持させる。担持させる金属は白金、ロジウム、ニッケル、銅等であり、金属酸化物は酸化ルテニウム等である。そして、その担持量は半導体の0.001~50重量%、好ましくは0.01~10重量%である。なお、金属や金属酸化物は担持触媒製造の際の常法で担持させれば良く、例えば含浸法で水溶性金属塩を担持させてから水素還元する方法で金属を担持させたり、光電着法、沈澱法、イオン交換法等で担持させることができる。

【0006】触媒Aを構成する半導体光触媒は2種類で も3種類以上でも良いが、触媒種が多いほど高活性の傾 向にある。また、通常は高活性半導体光触媒が含まれて いる方が高活性なので、半導体光触媒の中で格段に高活 性な金属担持二酸化チタンと、高活性で安定性等にも問 題のない酸化物半導体光触媒から成るものが好ましい。 なお、ここで使われる酸化物半導体光触媒としては、金 属担持酸化タンタル、金属担持チタン酸ストロンチウ ム、酸化ジルコニウム等が挙げられる。触媒Aを構成す る個々の半導体光触媒は、その存在比や形状を広い範囲 で変えることができる。例えば、一種類の半導体光触媒 の存在比は全触媒の0.01~99.99重量%、好ま しくは1~99重量%とすれば良い。しかし、通常は存 在比によって触媒活性が変動し、一般に触媒Aを構成す る触媒全部がほぼ同重量の場合に最高活性の触媒が得ら れる。

【0007】触媒Aを構成する個々の半導体光触媒は、 粉末状、粒子状、膜状等の種々の形状とすることができ る。そして、個々の触媒は同じ形状でも異なっていても 良いが、全触媒をほぼ同じ大きさの粉末状とするのが好 ましく、その平均粒径は0.005~100μm、好ま しくは $0.01\sim10\mu$ mとするのが良い。また、半導 体光触媒を不活性担体や異種半導体光触媒に担持しても 良いし、複数の半導体光触媒を担持上に積層して触媒A とすることもできる。例えば、紫外光透過性基板上に2 種類以上の半導体光触媒を薄膜状に積層し、これを触媒 Aとすることできる。なお、膜状触媒は基板を使っても 使わなくても作製可能であるが、どの場合も薄膜とする のが好ましい。以上に詳記した触媒Aは、それを構成す る半導体光触媒より大幅に高活性となる。その理由は不 明であるが、複数の触媒が光反応に関与することによる 相乗効果に基づくものと考えられる。

【0008】本発明の第二の触媒(以下、この触媒を触媒Bとも云う)は、紫外光透過性無機物粉末(以下、この粉末を単に無機粉末とも云う)と各種形状の半導体光触媒から成る触媒である。ここで使われる半導体光触媒は、触媒Aに含まれているそれと同じ物であり、触媒Aの場合と同様に酸化物半導体光触媒、特に金属担持二酸化チタンが好ましい。また、半導体光触媒は単一物でも二種以上混合物あっても良いし、その形状は触媒Aの場

合と同程度の大きさの粉末状、粒子状、膜状等とすれば 良いが、半導体光触媒の形状を無機粉末と同程度の粒度 の粉末とするのが好ましい。このようにすれば、触媒を 安価に製造できる上に触媒活性も高くすることができ る。

【0009】触媒Bを構成する無機粉末は、反応系で安定な紫外光透過性無機物粉末であれば限定されないが、無機酸化物粉末が好ましい。具体的には、シリカ、アルミナ、ゼオライト等の粉末が好ましい。粉末の平均粒径は0.005~100 μ m、好ましくは0.01~10 μ mとするのが望ましく、その存在量は半導体光触媒の0.1~99.9重量%、好ましくは1~99重量%とするのが望ましい。以上に詳記した触媒Bは、それを構成する半導体光触媒だけを触媒とした場合より大幅に高活性となる。その理由は明確でないが、無機粉末が併存していると照射された光が無機粉末によって散乱し、そのために半導体光触媒への光照射が均一化することによるものと考えられる。

【0010】本発明の光触媒反応方法では、単一の半導 体光触媒を使う代りに触媒A又は触媒Bを使用するが、 それ以外は従来公知の半導体光触媒反応方法と同様に行 えば良い。従って、光源や反応装置は従来の半導体光触 媒反応時と同じで良いし、反応条件も従来公知の条件を そのまま適用すれば良い。例えば、本発明法によって水 分解法水素を製造する際は、従来の半導体光触媒を使用 する水分解条件で反応させれば良く、本発明法によって 有害有機物を分解無害化する際は従来の半導体光触媒を 使う同一反応時と同条件で反応させれば良い。そして、 光源には触媒に使う半導体のバンドギャップより大きな エネルギーレベルにある光を照射できるもの、例えば高 30 圧水銀灯やキセノンランプ等を使えば良いし、光源は反 応器内(内部照射型)に設けても反応器外(外部照射 型)に設けてもよい。また、照射光としては太陽光も使 うことができる。そして、光源から出る光が半導体光触 媒に到達するまでに吸収されないように、光路となる部 分の反応器や光学系は紫外線を透過する石英や透明樹脂 で作るのが良く、半導体光触媒は薄膜状や懸濁状で反応 系内に存在させるのが望ましい。そのため、反応系内を 良く攪拌したり反応器と光源の形状及び両者の位置関係 について配慮するのが望ましい。

[0011]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はこの実施例によって限定されな い。なお、以下に記す%はいずれも重量%である。

【0012】実施例1~8

400Wの高圧水銀灯を光源とし、これを反応器内に設けた石英製の内部照射型液相反応器を使って有機化合物又は水の光分解実験を行った。この反応器は、圧力計とガスサンプラーを備えた内容積650ミリリットルの気密反応器で、反応器内容物はマグネチックスターラーで良く攪拌することができる。この反応器に、精製水350ミリリットルと有機化合物又は精製水5ミリリットルと触媒A又はB1gを仕込み、反応器内を脱気後にアルゴンを導入して反応器内圧力を約27トールとしてから、液の攪拌と光照射を開始して室温減圧下に有機化合物又は水の光分解実験を行った。なお、有機化合物と水が共存している系では有機化合物の光分解反応が優先して進行する。

【0013】水や有機化合物の光分解反応では水素を主 成分とするガスと液状物が生成するから、光照射開始後 は反応器内圧が次第に増加する。そこで、反応開始後は 10分毎に反応器内圧を測定するとともに、反応開始後 1時間までに得られたガス状生成物をオンラインでガス クロマトグラフ法によって分析し、反応開始から1時間 後までの水素生成速度を求めた。また、反応開始後1時 間までに生成した液状生成物をガスクロマトグラフ法と イオンクロマトグラフ法で分析し、生成物を確認した。 実施例1~8では、2~4種の半導体光触媒を等重量混 合した粉末触媒1gを使いた。触媒は、半導体粉末に1 %の白金を光電着法によって担持させた触媒である。な お、白金源には塩化白金酸を使った。また、触媒用半導 体粉末の二酸化チタンTiO2は日本エアロ ジル社製 P-25、酸化タンタルTa2 O5 とチタン酸ストロン チウムSrTiO3 は和光純葉社製品、酸化ジルコニウ ムZrO2は添川化学社製品であり、シリカゲルSiO 2 はダビソン社製の#57である。実施例1~8で使っ た粉末状半導体光触媒の種類と、被分解物と、水素生成 速度を表1に、確認されたガス状及び液状生成物の種類 を表2に示す。

[0014]

0 【表1】

实施例	触媒	被分解物	水素生成速度 (ミリモル/hr)
1	Pt-TiOz+Pt-TazOz	メタノール	11.69
2	Pt-TiO ₂ +Pt-ZrO ₂	メタノール	10.27
3	Pt-TiO _s +Pt-SrTiO _s	メタノール	11.53
4	Pt-TiO _z +Pt-Ta _z O _s +Pt-ZrO _z	メタノール	11.85
5	Pt-TiO ₂ +Pt-Ta ₂ O ₅ +Pt-ZrO ₂ +Pt-SrTiO ₃	メタノール	17.06
6	Pt-TiO ₂ +Pt-Ts ₂ O ₅	イソプロパノール	21.33
7	Pt-TiO _z +Pt-Ta _z O _s +Pt-ZrO _z	イソプロパノール	23.70
8	Pt-TiO ₂ +Pt-Ta ₂ O ₅	新版	8.85

[0015]

【表2】

実施例	ガス状生成物	被状生成物		
1	H _z , CO _z *1, CO , CH,	нсоон , нсно , сн₃осн₃		
2	H _z , CO _z , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн, осн,		
3	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн. осн.		
4	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн, осн,		
5	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн, осн,		
6	H ₂ , CO ₂ , CH ₄			
7	H ₂ , CO ₂ , CH ₄			
8	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄ *2			

- *1 水素生成量の6容量%生成
- *2 生成速度 4.42ミリモル/hr
- . *3 生成速度 0.08ミリモル/hr

【0016】比較例1~12

実施例1~10と比較するために、粉末状半導体光触媒及びシリカゲル粉末をを単独使用する以外は実施例と同様にして比較例の実験を行った。すなわあち、比較例1~9では0.1%の白金を担持した粉末状半導体1gを 40触媒とし、比較例10及び12ではシリカゲル粉末1g

を触媒とし、比較例11では酸化ジルコニウム粉末1gを触媒として実施例と同様な光分解反応を試み。使用した触媒の種類と被分解物と水素生成速度を表3に、確認されたガス状及び液状生成物の種類を表4に示す。

[0017]

【表3】

- 8

比較例	烛媒	被分解物	水素生成速度 (ミリモル/hr)
1	Pt-TiO ₂	メタノール	4.27
2	· Pt-Ta ₂ 0 _s	メタノール	3.16
3	Pt-ZrO ₂	メタノール	2.69
4	Pt-SrTiO₃	メタノール	2.84
5	Pt-TiO ₂	イソプロパノール	13.43
6	Pt-Ta _z O _s	イソプロパノール	3.63
7	Pt-ZrO₂	イソプロパノール	3,16
8	Pt-TiO₂	酢酸	6.48
9	Pt-Ta _z 0 _s	酢酸	2.05
10	SiO₂	水	≑ 0
11	ZrO₂	水	0.12
12	SiO ₂	メタノール	≑0

[0018]

【表4】

40

30

比較例	ガス状生成物	被状生成物
1	H ₂ , CO ₂ *1, CO , CH.	нсоон , нено , ен оен
2	H ₂ , CO _z , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн. осн.
3	H_z , CO_z , CO , CH_4	нсоон , нсно , снаосна
4	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄	нсоон , нсно , сн,осн₃
5	H _z , CO _z , CO , CH ₄	
6	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄	
7	H _z , CO _z , CO , CH ₄	
8	H_z , CO_z , CO , CH_z^{*2}	
9	H ₂ , CO ₂ , CO , CH ₄ *3	
10	Hz	
11	H ₂ , O ₂ *4	
12	H ₂	

*1 水素生成量の4容量%生成

*2 生成速度 1.02ミリモル/hr

*3 生成速度 1.78ミリモル/hr

*4 生成速度 0.06ミリモル/hr

【0019】実施例1と比較例1及び2との比較、実施 例2と比較例1及び3との比較、実施例3と比較例1及 び4との比較、実施例4と比較例1~3との比較、実施 例5と比較例1~4との比較、実施例6と比較例5及び 6との比較、実施例7と比較例5~7との比較、実施例 8と比較例8及び9との比較、及び実施例10と比較例 1及び12との比較から2種類以上の粉末状半導体光触 媒を併用したり粉末状半導体光触媒にシリカゲル粉末を 混合して使用すると、触媒活性が大幅に向上することが 明らかに認められる。例えば、実施例1の実験結果と比 較例1及び2の実験結果とを比較すると、2種類の触媒 を併用する実施例1の場合は触媒使用量が合計1gで水 素生成速度11.69ミリモル/hrとなるのに、触媒 を単独使用する比較例1及び2の場合は合計触媒使用量 40 が2gなのに両実験で生成する水素の生成速度は合計し ても7. 43ミリモル/hrにすぎず、実施例の場合の 6割強の水素生成速度しか得られていない。

[0020]

【発明の効果】本発明によれば、半導体光触媒を使用する水分解や環境汚染物質の酸化分解等が従来法より大幅に効率良く行われるようになる。従って、太陽光線で水

を分解して水素ガスを製造する方法の実現可能性が高くなると共に、現在でも下記のような用途に利用することができる。

- ① 病院や老人ホーム等の建物の内壁に2種類以上の半導体光触媒粉末の混合物(以下、この混合物を混合粉末触媒とも云う)を塗布すると、該触媒による温和な光酸化分解反応が進行するために殺菌及び消臭効果が得られる。
 - ② 蛍光灯のフードに混合粉末触媒を塗布すると、①の 場合と同様な光酸化分解反応が進行するから該蛍光灯が 存在する室内の消臭に有効である。
 - ③ ガラス製コップ等の透明食器類の表面に混合粉末触 媒を塗布すると、前記と同様に温和な光酸化分解反応が 進行するから殺菌、消臭及び汚染物除去等に有効である。
 - ④ 貯水池、川、池等の水中に混合粉末触媒を存在させると、前記と同様にして太陽光によって農薬、ヘドロ、環境汚染性有機物等が光酸化分解して除去される。
 - ⑤ 有機物で汚染された海水やNOx及びSOx等で汚染 された大気は、太陽光を照射しながら混合粉末触媒が充 填している層を通過させると不純物が分解除去される。

フロントページの続き

(51) Int.C1.⁷

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 1 B 3/22

B O 1 J 23/64 1 O 2 M

(72)発明者 岡部 清美

茨城県つくば市東1丁目1番 工業技術院

物質工学工業技術研究所内

(72)発明者 荒川 裕則

茨城県つくば市東1丁目1番 工業技術院

物質工学工業技術研究所内

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)